



「逆導通対応パワー半導体デバイス・応用の最新技術」

◇ 日時： 2019 年 2 月 27 日（水） 13:30～17:00

◇ 場所： 梅田スカイビル 36 階 スペース 36L、〒531-6023 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番 88 号
(JR 大阪駅から…徒歩約 7 分 <http://www.skybldg.co.jp/access/walk.html>)

Si、SiCなどのMOSFETでは、内蔵ダイオードを活用する素子の性能進化や実用化開発が盛んに行われている。また、一つの素子にダイオード領域とMOSFET領域を形成した混載型デバイスの開発も進んでいる。今回は、逆導通に対応するパワー半導体デバイスにフォーカスをあて、現在実用化されている、Si-SJMOS、RC-IGBT、DioMOS、開発が進展しているSBD内蔵MOSFET、および、SiCのボディダイオード活用時のバイポーラー劣化対策などの技術面での最新研究成果について、多彩な講師の方にご講演いただき、ワイドギャップ半導体のさらなる発展の方向性や適する応用分野について議論する。

.....プログラム.....

開会のあいさつ **13:30～13:35**

Si-SJMOS 開発動向 **13:35～14:05**
齋藤 渉（東芝デバイス&ストレージ株式会社）

RC-IGBT の開発動向 **14:05～14:35**
小野沢 勇一（富士電機株式会社）

還流ダイオード機能を有する SiC パワーMOSFET (DioMOS) **14:35～15:05**
大岡 篤志（パナソニック株式会社）

休憩 15:05～15:25

ボディダイオードの不活性化を実現する SBD 内蔵 MOSFET **15:25～15:55**
日野 史郎（三菱電機株式会社）

SiC-MOSFET 内蔵ダイオードの通電劣化に関する課題と対策 **15:55～16:25**
土田 秀一（電力中央研究所）

パワーデバイスのボディダイオード課題に対する回路技術 **16:25～16:55**
只野 博（筑波大学）

閉会のあいさつ **16:55～17:00**

.....

■参加受付： WEB 参加受付システム([ここ](#)をクリック*)から参加登録をお願いします。2月18日の登録状況でテキスト印刷部数を決定しますので、以後の登録ではテキストを当日お渡しできない可能性があります。

*本案内が印刷物の場合、<https://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai13.pdf> よりアクセスして下さい。

■参加費： (テキスト代・消費税込) 当日会場にてお支払いください。

先進パワー半導体分科会会員* 2,000 円、分科会学生会員 1,000 円、一般 4,000 円、一般学生 1,000 円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

問合せ先:

多留谷 政良(三菱電機)	TEL: 092-805-3289	e-mail: Tarutani.Masayoshi@da.MitsubishiElectric.co.jp
服部 佳晋(豊田中央研究所)	TEL: 0561-71-7766	e-mail: y-hattori@mosk.tytlabs.co.jp
上野 勝典(富士電機)	TEL: 042-585-6598	e-mail: ueno-katsunori@fujielectric.com
五十嵐 周(応用物理学会事務局)	TEL: 03-3828-7723	e-mail: igarashi@jsap.or.jp